

イーケムソリューションズのユニークな フォトレジスト

< 抜粋 >

Dual Tone Resist

一つのレジストが
ポジにもネガにもなる

<標準ポジプロセス>	<ネガプロセス>
レジスト塗布	レジスト塗布
プリベーク	プリベーク
露光	露光
	Post Exposure Bake
	一括露光
現像	現像

厚膜フォトレジスト "ePR THICK"

膜厚: 10um
5um L&S

高耐熱フォトレジスト "ePR HTg"

ポストベーク温度
120°C 140°C 160°C

現像後パターン

逆テーパレジスト "ePR-77N"

テーパ角は
プロセスで
制御可能

超高耐熱フォトレジスト HTg Super

No bake 250°C 300°C

一般的ポジ
フォトレジスト

リソグラフィー保護膜形成用溶液 "eProtect"

eProtect塗布基板

未露光部
露光部に
かかわらず

現像液にも
耐性がありながら、
剥離液には簡単に溶解

エッチング液にも

通常樹脂膜では
Cr膜

保護膜としての機能不完全

MEMS用フォトレジスト

- Film thickness: 109um (1200rpm x 30sec, 4 inch wafer)
- Photosensitivity: 80mJ/cm2 (Broad band exposure)

L/S: 100um	L/S: 50um	L/S: 25um
L/S: 100um	Dot: 50um	Dot: 25um

イーケムソリューションズジャパン(株)